

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-206183

(43)公開日 平成11年(1999) 7月30日

(51)Int.Cl.⁴
H 0 2 P 7/63
H 0 2 J 7/00
H 0 2 M 7/537

識別記号
3 0 2

F I
H 0 2 P 7/63 3 0 2 C
H 0 2 J 7/00 P
H 0 2 M 7/537 Z

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 10 頁)

(21)出願番号 特願平10-4211

(22)出願日 平成10年(1998) 1月12日

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所
東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地

(72)発明者 山村 博久

茨城県ひたちなか市大字高場2520番地 株
式会社日立製作所自動車機器事業部内

(72)発明者 正木 良三

茨城県日立市大みか町七丁目 1 番 1 号 株
式会社日立製作所日立研究所内

(72)発明者 田原 和雄

茨城県日立市大みか町七丁目 1 番 1 号 株
式会社日立製作所日立研究所内

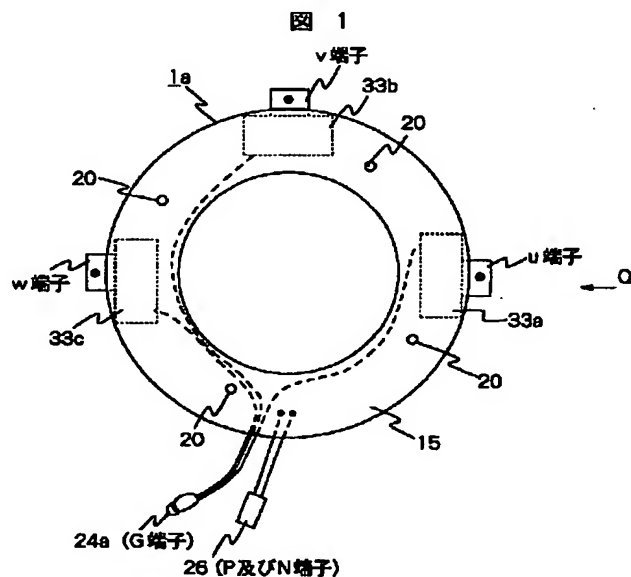
(74)代理人 弁理士 高田 幸彦 (外 1 名)

(54)【発明の名称】 回転電機内蔵用インバータ及びそれを用いたインバータ内蔵形回転電機

(57)【要約】

【課題】耐熱性を向上し冷却フィン寸法や回転電機の小型化に結び付く回転電機内蔵用インバータを提供する。

【解決手段】回転電機内蔵用のインバータ 1 a は、回転電機に内蔵されて用いられ複数個のモジュール 33 (33a, 33b, 33c) を含み形成されたインバータ回路を有するものであって、モジュール 33 を構成するパワートランジスタおよびダイオードは、 $T_j = 160^{\circ}\text{C}$ 以上 $\sim 300^{\circ}\text{C}$ 以下のジャンクション温度特性を有している。従って、同一使用温度環境であれば、冷却フィンとしての正極板 15 及び負極板 16 の寸法を従来より小さくすることができ、インバータ 1 a 自体や内蔵されて用いられる回転電機の小型化に結び付くものである。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 複数の半導体モジュールを含み形成されたインバータ回路を回転電機に内蔵して成る回転電機内蔵用インバータであって、

前記半導体モジュールを構成するパワートランジスタ及びダイオードは、

$T_j = 160^\circ\text{C}$ 以上 $\sim 300^\circ\text{C}$ 以下のジャンクション温度特性を有していることを特徴とする回転電機内蔵用インバータ。

【請求項 2】 請求項 1 において、前記パワートランジスタは、SiC 組成材を用いた SIT 形半導体から成り、前記ダイオードは、SiC 組成材を用いた SiC 形ダイオードから成ることを特徴とする回転電機内蔵用インバータ。

【請求項 3】 複数の半導体モジュールにより形成されたインバータを内蔵するインバータ内蔵形回転電機であって、

前記インバータの前記半導体モジュールを構成するパワートランジスタ及びダイオードは、 $T_j = 160^\circ\text{C}$ 以上 $\sim 300^\circ\text{C}$ 以下のジャンクション温度特性を有していることを特徴とするインバータ内蔵形回転電機。

【請求項 4】 請求項 3 において、前記半導体モジュールの前記パワートランジスタおよび前記ダイオードの前記 T_j を、 220°C 以上 $\sim 300^\circ\text{C}$ 以下の範囲としたことを特徴とするインバータ内蔵形回転電機。

【請求項 5】 請求項 4 において、前記半導体モジュールは、前記インバータ内蔵形回転電機のステータコイルエンド近傍に配設されていることを特徴とするインバータ内蔵形回転電機。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、回転電機、特に電気車の電動機に内蔵して用いられるための損失、冷却、小型化等の面を考慮したインバータに係り、該インバータを内蔵した回転電機に関する。

【0002】

【従来の技術】 電気車、特に電気自動車においては、航続距離の向上から効率の良い駆動システムが要求されており、堅牢な誘導電動機に代わって小型化・高効率を図るために永久磁石を用いた同期電動機が多用されており、さらに、インバータが電動機に内蔵される方向に進んできている。そして、電動機を含む回転電機の小型化を損なわずにインバータを内蔵する技術が開発されている。

【0003】 すなわち、内蔵して用いられる従来技術のインバータとしては、SiC 半導体の低損失化を活かして SiC 半導体からなる 3 相全波整流器を車両用交流発電機の後端壁以外の部位へ固定することができるようにして内蔵する車両用交流発電機用のインバータが、特開平 8-336268 公報に開示されている。また、イン

バータを電動機に内蔵した従来技術のインバータ内蔵形回転電機としては、ヒートシンクを介して電動機とコントローラ(含むインバータ)を一体にして内蔵する技術が、特開平 5-292703 号公報に開示されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上記従来技術の回転電機内蔵用インバータおよびインバータ内蔵形回転電機には、小型化することが困難であるという共通の問題がある。即ち、インバータとしては、インバータ主回路の素子として Si(シリコン)を用いた半導体が用いられており、その熱損失が大きく半導体の耐熱保護の面から設ける冷却フィン寸法に制約がある。具体的には、IGBT と呼称されている半導体、または、上記特開平 8-336268 公報に記載の SiC 半導体の接合部の許容温度値が 155°C 位にあるため、冷却フィンを小型化するには限度がある。逆に、インバータの使用温度環境が高くなればなるほど冷却フィン寸法は大きくなる。

【0005】 一方、インバータを内蔵する回転電機としては、回転電機の内部が $150^\circ\text{C} \sim 180^\circ\text{C}$ 位になり、インバータ、即ち、半導体の冷却を考慮すると、小型化を損なわずに内蔵することが難しいという問題がある。特に、内燃機関と電動機を使用したハイブリッドシステムカーの場合の電動機では、エンジンの発熱の影響を受けるためインバータの温度環境は 200°C 前後となるので、高温動作可能でかつ低損失なインバータが要望され、この点からも小型化を損なわずインバータを電動機に内蔵する技術の必要に迫られている。

【0006】 従って、本発明の目的は、冷却フィンを小型化できる回転電機内蔵用インバータを提供することにある。また、他の目的は、回転電機内蔵用インバータを内蔵しつつ小型化したインバータ内蔵形回転電機を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】 上記目的を達成する本発明による回転電機内蔵用インバータの特徴は、複数の半導体モジュールを含み形成されたインバータ回路を回転電機に内蔵して成る回転電機内蔵用インバータであって、前記半導体モジュールを構成するパワートランジスタ及びダイオードは、 $T_j = 160^\circ\text{C}$ 以上 $\sim 300^\circ\text{C}$ 以下のジャンクション温度特性を有している点にある。そして、前記パワートランジスタは、SiC 組成材を用いた SIT 形半導体から成り、前記ダイオードは、SiC 組成材を用いた SiC 形ダイオードから成ることが望ましい。

【0008】 また、本発明によるインバータ内蔵形回転電機の特徴は、複数の半導体モジュールにより形成されたインバータを内蔵するインバータ内蔵形回転電機であって、前記インバータの前記半導体モジュールを構成するパワートランジスタ及びダイオードは、 $T_j = 160^\circ\text{C}$ 以上 $\sim 300^\circ\text{C}$ 以下のジャンクション温度特性を有しているところにある。そして、前記半導体モジュールの前

記パワートランジスタおよび前記ダイオードの前記 T_j を、 220°C 以上 $\sim 300^{\circ}\text{C}$ 以下の範囲とすることが望ましい。更に、前記半導体モジュールは、前記インバータ内蔵形回転電機のステータコイルエンド近傍に配設されていることが好ましい。

【0009】本発明によれば、インバータ回路を形成する半導体モジュールのジャンクション温度特性が高いので、同一使用温度環境であれば冷却フィン寸法は従来より小さくすることができ小形化に結び付く回転電機内蔵用インバータが提供される。また、耐熱性を向上した回

【0010】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。まず、本発明による回転電機内蔵用インバータの第1の実施例について、図1～図6を参照して説明する。図1は、本発明による一実施例の回転電機内蔵用インバータを示す正面図である。回転電機内蔵用インバータの一例としてのインバータ1aを示している。図2は、図1の回転電機内蔵用インバータを示す側面図である。即ち、図1のQ矢視図である。

【0011】図1、図2において、インバータ1aは、u、v、w端子をそれぞれ突き出している3個の半導体モジュールとしてのモジュール33(33a、33b、33c)と、該各モジュール33をボルト20及びナット21を介して電気的に接続しつつ圧接挟持する円環形状の正極板15及び負極板16と、各モジュール33のゲート端子に電気接続している信号線(G端子)24aと、正・負極板15、16に電気接続している電源線(正極のP端子及び負極のN端子)26とから構成される。

【0012】尚、正・負極板15、16は、モジュール33、即ち、半導体を冷却するために設けられる冷却フィンを用いているものである。そして、本実施例では冷却フィンとしての正・負極板15、16を一体形の円環形状としたが、冷却フィンを3個にそれぞれ分割し、即ち、正・負極板を3個にそれぞれ分割してなる3個の分割した半導体モジュールから構成して、該半導体モジュールから形成されるインバータ(図示省略)であっても可である。

【0013】一方、図3は、本発明による一実施例のモジュールを示す断面図である。そして、図4は、図3のモジュールの回路構成図である。図3、図4において、モジュール33は、即ち、モジュール33a、33b、33cは、2個のパワートランジスタ38(以下、パワートラ38)と、2個のダイオード39と、コレクタ35と、エミッタ36と、中間端子37と、2個のゲート32(含むゲート電線32a及びゲート電極32b)と、成形体31とから構成される。所謂、

モジュール33は、2つのパワートランジスタと2つのダイオードからインバータ回路を形成する構造のものであり、図示した内部回路で構成されている。そして、コレクタ35と、一方のパワートラ38及びダイオード39の対と、中間端子37と、他方のパワートラ38及びダイオード39の対と、エミッタ36とを順に積層し、成形体31にて一体に組付けた半導体モジュールの構造である。

【0014】なお、インバータ回路に用いられる半導体モジュールは、2つのダイオードを含まず2つのパワートランジスタだけにて構成することも可である。さらに、前述の分割した構成のインバータであれば、上記のコレクタ35及びエミッタ36を、冷却フィンとしての正・負極板と兼用した半導体モジュールから構成して、該半導体モジュールから形成されるインバータ(図示省略)とすることも可である。

【0015】更に、図1～図3に示すように、モジュール33a、33b、33cは、圧接挟持する導電体であり且つ熱良導体(例えば、アルミ板)としての正極板15及び負極板16に、コレクタ35の正極側接触面(点)15s及びエミッタ36の負極側接触面(点)16sを介して電気的に接続されると同時に、モジュール33内の半導体としてのパワートラ38及びダイオード39で発生する熱をコレクタ35及びエミッタ36を経て正極板15及び負極板16から放散している。そして、該正極板15及び負極板16に接続された電源線26から、各電極のP端子及びN端子が取り出されている。また、モジュール33(33a、33b、33c)の信号線24aに接続されるゲート32から、G端子が取り出されている。更に、2個のパワートラ38の中立点としての中間端子37から、u端子(及びv、w端子)が取り出されている。

【0016】なお、本実施例のモジュール33の各u、v、w端子は、後述する同期電動機30のステータコイル3との直接接続が可能である構造としている。また、3相交流の場合として、3個のモジュール33を用いている。さらに、インバータ1aの形状は、ステータコイルエンドに沿って行われる配設が容易に可能とするために円環形状(含む半円環形状や馬蹄形状)から成っていて、同期電動機30の空きスペースの有効活用を促進している。

【0017】そして、本発明による回転電機内蔵用インバータの特徴とする構成は、半導体モジュールを構成するパワートランジスタ及びダイオードが、 $T_j = 160^{\circ}\text{C}$ 以上 $\sim 300^{\circ}\text{C}$ 以下のジャンクション温度特性を有している点にある。上記の $T_j = 160^{\circ}\text{C}$ 以上 $\sim 300^{\circ}\text{C}$ 以下のジャンクション温度特性を有する半導体モジュールについて説明する。図5は、本発明による一実施例の回転電機内蔵用インバータに用いられる半導体モジュールのジャンクション温度特性を示す図である。縦軸はもれ電流(A)を、横軸はジャンクション温度 $T_j (^{\circ}\text{C})$ を示し、モジュール温度に対するもれ電流の変化状態を表わしている。

【0018】図5において、図3に示した本発明品(例えば、SiC-SIT)の半導体モジュール(すなわち、内部の半導体としてのパワートランジスタ及びダイオード)は、約230°Cの近辺においても電流値が急増し、所謂、もれ電流が発生していることが分かる。これに対して、従来品(例えば、Si-IGBT, SiC-MOSFET)の半導体モジュールは、約155°Cの近辺からもれ電流が発生していることが分かる。従って、半導体モジュールの接合部の許容温度値(保証温度値)としてのジャンクション温度 T_j が高くなっていて、図5に示す本発明品の半導体モジュールを構成するパワートランジスタ及びダイオードは、 $T_j=230^\circ\text{C}$ のジャンクション温度特性を有している。これに対し従来品は、 $T_j=155^\circ\text{C}$ のジャンクション温度特性を有している。尚、現時点の従来品の T_j は、160°C未満である。

【0019】さらに、具体的な例として、 $T_j=160^\circ\text{C}$ 以上 $\sim 300^\circ\text{C}$ 以下のジャンクション温度特性を有する半導体モジュールのパワートランジスタ38は、SiC組成材を用いたSIT形半導体から構成される。また、ダイオード39は、SiC組成材を用いたSiC形ダイオードから構成されている。従って、SiC組成材を用いたSIT形半導体のパワートランジスタ38と、SiC形ダイオードのダイオード39とから構成される半導体モジュールとしての、本第1の実施例に取り上げたモジュール33は、SiC形モジュールである。

【0020】なお、最近の各種検討によって、 $T_j=160^\circ\text{C}$ 以上 $\sim 300^\circ\text{C}$ 以下の範囲にある半導体としてのパワートランジスタ及びダイオードが得られている。さらに、 $T_j=300^\circ\text{C}$ を越える半導体(含む半導体モジュール)を得ることも可能であるが回転電機用の半導体(含む半導体モジュール)としては、(1)回転電機の実用限界温度を越える、(2)ウェハの歩留まりが悪化する、(3)生産性が悪く高価になる、(4)大形化するなどの点から、 $T_j=300^\circ\text{C}$ を越えることは好ましくない。また、SiC組成材以外の他の材料を採用したワイドギャップ形半導体にて、 $T_j=160^\circ\text{C}$ 以上 $\sim 300^\circ\text{C}$ 以下の範囲にある半導体モジュールを作成できることを把握している。

【0021】そして、上記の $T_j=160^\circ\text{C}$ 以上 $\sim 300^\circ\text{C}$ 以下のジャンクション温度特性を有したパワートランジスタ及びダイオード(または、パワートランジスタのみ)から構成された半導体モジュールによって形成されたインバータ回路を有する回転電機内蔵用インバータは、同一使用温度環境の場合においては、冷却フィン寸法を従来より小さくすることができる。換言すれば、従来品の $T_j=155^\circ\text{C}$ に比べて、 $T_j=230^\circ\text{C}$ とした本実施例のインバータの場合であれば、冷却フィン寸法を小さくした分だけ温度上昇しても耐えられることになり、冷却フィンとしての正・負極板15,16が小形化されることになる。さらに、 $T_j=230^\circ\text{C}$ である本実施例の半導体モジュールを用いた回転電機内蔵用インバータであれば、耐

熱性を有しているため、回転電機の内部が $150^\circ\text{C}\sim 180^\circ\text{C}$ 位になる場合であっても内蔵することが十分に可能であり、さらにまた、例えば、回転電機の冷却ファンを大きくすることもなく内蔵することができるという効果が得られる。

【0022】従って、複数の半導体モジュールを含み形成されたインバータ回路を回転電機に内蔵して成る回転電機内蔵用インバータであって、半導体モジュールを構成するパワートランジスタ及びダイオードは、 $T_j=160^\circ\text{C}$ 以上 $\sim 300^\circ\text{C}$ 以下のジャンクション温度特性を有している本発明による回転電機内蔵用インバータの構成であれば、耐熱性が向上し、冷却フィン寸法や回転電機の小形化に結び付けることができる。また、複数の半導体モジュールを含み形成されたインバータ回路を回転電機に内蔵して成る回転電機内蔵用インバータであって、半導体モジュールを構成するパワートランジスタは、 $T_j=160^\circ\text{C}$ 以上 $\sim 300^\circ\text{C}$ 以下のジャンクション温度特性を有している回転電機内蔵用インバータであっても、上記と同様な効果が得られることは明らかである。

【0023】一方、SiC組成材を用いたSIT形半導体のパワートランジスタ38は、前述のように高温動作可能であることに加えて、低損失である、即ち、発熱量が少ないことが判明した。図6は、本発明による一実施例の半導体モジュールを構成するパワートランジスタの定格電圧 V_{ce} (コレクタ・エミッタ間の定格電圧)に対するオン抵抗特性を示す図である。縦軸はオン抵抗($\text{m}\Omega\cdot\text{cm}^2$)を、横軸は定格電圧 $V_{ce}(\text{V})$ を示し、図5に示した本発明品(SiC-SIT)の $T_j=230^\circ\text{C}$ のジャンクション温度特性を有しているパワートランジスタのオン抵抗特性を、従来品(Si-IGBT, SiC-MOSFET)のオン抵抗特性と比べて表わしている。

【0024】図6において、本発明品のSiC組成材を用いたSIT形半導体としてのパワートランジスタは、従来品のパワートランジスタに比べて、定格電圧 V_{ce} の広い範囲に亘って、オン抵抗が小さいことが分かる。具体的には、本実施例の回転電機内蔵用インバータを電気車用の永久磁石形同期電動機に用いて、定格電圧 $V_{ce}=600\text{V}\sim 3000\text{V}$ の範囲と、スイッチング周波数 $10\text{kHz}\sim 100\text{kHz}$ の範囲とで動作させると、半導体モジュールの順方向飽和電圧が、従来形半導体モジュール(例えば、IGBTモジュール)の $1/6$ の 0.3V とすることができて、低熱損失化されることが判明した。また、本実施例の回転電機内蔵用インバータを、車両用交流発電機(定格電圧 $V_{ce}=24\sim 100\text{V}$ の範囲)に採用しても、同様の低熱損失効果が得られることは、図6から明らかに理解できる。

【0025】したがって、パワートランジスタ38が、SiC組成材を用いたSIT形半導体から成る半導体モジュールにより形成されたインバータ回路を有する回転電機内蔵用インバータは、高耐熱性と低熱損失性とを備え

るので、さらに、冷却フィンを小形化すると言える。即ち、回転電機の小型化を損なわずインバータを該回転電機に内蔵することができ、回転電機の小形化に結び付く回転電機内蔵用インバータが提供される。

【0026】次に、図7～図9を参照して第2の実施例について説明する。図7は、本発明による他の実施例の回転電機内蔵用インバータを示す正面図である。回転電機内蔵用インバータとしての一体型インバータ1bを示している。図8は、図7の回転電機内蔵用インバータを示す側面図である。即ち、図7のR矢視図である。

【0027】図7、図8において、一体型インバータ1bは、u、v、w端子をそれぞれに有する3個の半導体モジュールとしてのモジュール13(13a, 13b, 13c)と、3個のコンデンサ14(14a, 14b, 14c)と、各モジュール13と各コンデンサ14をボルト20及びナット21を介して電氣的に接続しつつ圧接挟持する円環形状の正極板15及び負極板16と、各モジュール13に電気接続している信号線(Co端子)24bと、正・負極板15, 16に電気接続している電源線(P及びN端子)26とから構成される。尚、第1と第2の実施例にて表示した同一符号は、同一構成を表わしている。

【0028】また、図9は、図7の一体型インバータ1bのモジュール13の回路構成図である。図9において、モジュール13は、所謂2素子イン1インテリジェントモジュールと呼称される構造のものであり、3個のうちの一つのモジュール13aは、2個のパワートランジスタ(以下、パワトラ)18aと、2個のダイオード19aと、1個のインテリジェントドライバ(以下、ドライバ)17aとから、図示した内部回路で構成されている。

【0029】そして、図7～図9に示すように、モジュール13aとコンデンサ14aとは、圧接挟持する導電体としての正極板15及び負極板16自体を介して、正極側接触点15s及び負極側接触点16sにて電氣的に接続し、正極板15及び負極板16に接続した電源線26を介してそれぞれのP端子及びN端子が取り出されている。本実施例の場合も、正・負極板15, 16は、半導体を冷却するために設けられる冷却フィンを兼用しているものである。また、ドライバ17aからは、信号線24のCo端子が取り出され、更に、2個のSIT18aの中立点からは、u端子が取り出されている。尚、モジュール13b及び13cの構成はモジュール13aと同様である。

【0030】すなわち、第2の実施例の一体型インバータ1bの第1の実施例のインバータ1aとの構成の違いは、パワトラ18とダイオード19とドライバ17とを一体に成形したモジュール13と、平滑用のコンデンサ14とを、正極板15及び負極板16によって圧接挟持して、一体にして組み立てた点にある。尚、ドライバ17は、1チップドライバIC(集積回路)から構成されていて、このドライバ17を、2つのパワートランジスタ(本実施例ではパワトラ18)及び2つのダイオード(本実施例ではダイオード1

9)と一体にしてインバータ回路を形成した構成のそのものは、公知技術であり、図示説明は省略する。また、一体型インバータ1bは一体形状であるので、ドライバ17及びコンデンサ14は、パワトラ18やダイオード19と同等の耐熱性(即ち、同じ使用環境温度で正常に作動する機能)を有することが望ましい。例えば、ドライバ17内部の半導体はSiC組成材を用いたものであり、コンデンサ14は、セラミック形コンデンサである。

【0031】一方、本実施例の3個のモジュールの各u、v、w端子は、ステータコイル3との直接接続が可能である構造と成っている。耐熱性を向上した本実施例のモジュールを、回転電機内部の比較的空いている高温雰囲気スペースとしてのステータコイルエンド近傍に配設することによって、スペース効率の向上を図りインバータ内蔵形回転電機の小形化を達成することができる。従って、上記3個のモジュール13a, 13b, 13cからなる一体型インバータ1bの形状は、空きスペースの有効活用を促進し、かつ、ステータコイルエンドに沿って行われる配設が容易に可能とするために、円環形状(含む半円環形状や馬蹄形状)から成っていることが好ましい。

【0032】そして、本第2の実施例の一体型インバータ1bに用いられている半導体モジュールを構成するパワートランジスタ及びダイオードは、第1の実施例のインバータ1aに用いられている半導体モジュールと同様に、 $T_j = 160^{\circ}\text{C}$ 以上 $\sim 300^{\circ}\text{C}$ 以下のジャンクション温度特性を有している。すなわち、半導体モジュールのパワートランジスタ18は、SiC組成材を用いたSIT形半導体素子から成り、ダイオード19は、SiC組成材を用いたSiC形ダイオード素子から成っている。従って、SiC組成材を用いたSIT形半導体素子のパワートランジスタ18とSiC形ダイオード素子のダイオード19から構成される半導体モジュールとしての第2の実施例のモジュール13も、SiC形モジュールである。

【0033】従って、本第2の実施例の一体型インバータ1bは、第1の実施例のインバータ1aと同様の効果を発揮し、即ち、冷却フィン寸法を従来より小さくすることができる。また、低熱損失化される効果によって、さらに、冷却フィンを小形化すると言える。そして、ドライバ17やコンデンサ14をも含めて一体化したので、更に、回転電機の小形化を損なわずインバータを該回転電機に内蔵することができ、回転電機の小形化に結び付く回転電機内蔵用インバータが提供される。

【0034】ところで、第1の実施例に示すインバータ1aに用いた半導体モジュールは、一体型インバータ1bからコンデンサ14とドライバ17とを分離し、パワトラ38及びダイオード39だけをモジュール化した分離型のモジュール33である。従って、図1に示した3個のモジュール33を用いたインバータ1aの場合は、コンデンサ14は、例えば、同期電動機30の外に設置し、該モジュール33のドライバ制御を実行するドライバ17は、例えば、後

掲する図 11 に示すように、コントローラ 35 の一部として、同期電動機 30 の外に設置することになる。従って、インバータ 1a を採用する場合は、別に設けられるコンデンサ 14 やドライバ 17 の耐熱性は、従来品と同等で十分である。尚、インバータ 1a を採用する場合であっても、コンデンサ 14 やドライバ 17 の耐熱性に問題が起きないならば、同期電動機 30 の内部に該コンデンサ 14 やドライバ 17 を設置するも可である。

【0035】次に、本発明によるインバータ内蔵形回転電機について、回転電機の種類としてのハイブリッドシステムカーや電気自動車に用いられる永久磁石形同期電動機を例示した、図 10 を参照して説明する。まず、インバータ内蔵形回転電機としての永久磁石形同期電動機の構成について説明する。図 10 は、本発明による一実施例の回転電機内蔵用インバータを用いたインバータ内蔵形回転電機の構成を示す半断面図である。即ち、前述のインバータ 1a またはインバータ 1b を内蔵した同期電動機 30 を示している。図 10 に示す本実施例の同期電動機 30 は、インバータ 1c (例えば前述のインバータ 1a または 1b) と、リアブラケット 6、アルミブレード 7 及びフロントブラケット 8 などを含むモータボディ 10 と、ロータコア 4 や永久磁石 5 などを含むロータ 11 と、ステータコア 2 やステータコイル 3 などを含むステータ 12 とを含んで構成される。

【0036】即ち、永久磁石 5 は、ロータコア 4 の内部に分割して挿入されており、ステータコア 2 に巻かれたステータコイル 3 に印加する 3 相電圧・電流を制御することにより、同期電動機 30 からハイブリッドシステムカーや電気自動車の駆動力(トルクや回転速度)を得ている。ステータコア 2 は、リアブラケット 6 とアルミブラケット 7 の内部水路を流れる冷却水により冷却されている。フロントブラケット 8 は、電気自動車の架台やハイブリッドシステムカーの内燃機関に取り付けられる構造である。

【0037】そして、インバータ 1c を、高温雰囲気であるが同期電動機 30 の内部にあっては比較的空いているスペースであって、かつ、インバータ 1c との直結構造による電気接続の簡素化することが可能な、耐絶縁許容温度(MAX220℃)を満たすステータコイル 3 に近接して配設する構成とする。例えば、インバータ 1c の u, v, w 端子を同期電動機 30 のステータコイル 3 に直接接続する構成とする。

【0038】一般的に、図 10 に示したように同期電動機 30 においては、その内部空間はほとんど隙間がない位に有効に使われており、内蔵されるインバータに対する要求として、(1)インバータを小形化する、(2)内部空間を有効に利用する等がある。そして、比較的空いているスペース部分として、例えば、高温雰囲気ではあるが耐絶縁許容温度(MAX220℃)以下を満たすように設計されているステータコイル 3 のエンドコイル近傍がある。従っ

て、耐熱性が向上した回転電機内蔵用インバータであれば、スペースの有効利用によって回転電機の小型化が図られると考えられる。

【0039】即ち、本発明によるインバータ内蔵形回転電機の特徴とする構成は、半導体モジュールを構成するパワートランジスタ及びダイオードが $T_j = 220^\circ\text{C}$ 以上 $\sim 300^\circ\text{C}$ 以下のジャンクション温度特性を有している該半導体モジュールにより形成されたインバータを内蔵している点にある。更に、半導体モジュールをステータコイルエンドに直結する構造によって電気接続の簡素化にも繋がるので、インバータが電動機のステータコイルエンドに直結されていることが好ましいと言える。

【0040】次に、上記構成のインバータ内蔵形回転電機の動作について、回転電機内蔵用インバータの動作を絡めて、図 1, 図 7 ならびに図 10 ~ 図 12 を参照して説明する。図 11 は、図 1 のインバータ 1a を、同期電動機 30 の駆動回路に実装した場合の回路構成を示している。図 12 は、図 7 の一体型インバータ 1b を、同期電動機 30 の駆動回路に実装した場合の回路構成を示している。図 10 に示す同期電動機 30 の駆動回路は、インバータ 1a と、電源 40 と、コンデンサ 14 と、ドライバ 17 を含むコントローラ 35 と、各種センサ(エンコーダ 9 や電流センサ 23 など)と、同期電動機 30 とを含み構成される。そして、インバータ 1a のインバータ回路(の主回路部分)は、前述したような 3 個のモジュール 33 から構成される。また、図 11 に示す同期電動機 30 の駆動回路は、一体型インバータ 1b と、電源 40 と、コントローラ 25 と、各種センサ(エンコーダ 9 や電流センサ 23 など)と、同期電動機 30 とを含み構成される。そして、一体型インバータ 1b は、前述したような 3 個のモジュール 13 と、3 個のコンデンサ 14a, 14b, 14c (ただし、3 個を 1 つ纏めて図示)とから構成される。

【0041】上記のインバータの動作は、次の通りである。インバータ 1a, 1b は、電源 40 から電源線 26 を介して直流電源を入力する。コンデンサ 14 は、直流電源を平滑化する。それぞれのパワートラ 18, 38 及びダイオード 19, 39 からなるインバータ主回路は、信号線 24a, 24b を介してコントローラ 25, 35 から受けた制御信号に基づき、ドライバ 17 が実行するドライバ制御に従って、直流電源を交流電源に変換する。変換された交流電源は、各 u, v, w 端子から出力される。そして、本実施例のインバータ 1a, 1b は、耐絶縁許容温度(MAX220℃)以下を満たしつつ高温雰囲気に置かれたステータコイル 3 のエンドコイル近傍に直結されているが、その耐熱性によって正常に動作することができる。

【0042】一方、同期電動機 30 の駆動回路の動作は、コントローラ 25 が、電源 40 の直流電源を交流電源に変換するインバータ 1c のドライバ 17 を介した変換制御を実行すると同時に、エンコーダ 9 や電流センサ 23 などからの各種センサ信号を用いて、PWM 駆動制御を実行して

同期電動機30を駆動するものである。即ち、電流センサ23を用いて各U、V、W電流を検出し、マイコンなどから構成されるコントローラ25により所定値となるようデジタル制御し、更に、エンコーダ9によりA、B相信号と位置信号を取り込んでベクトル制御を行い、最も効率が高くなるように同期電動機30のPWM運転を実行している。

【0043】上記の構成と動作によって、該インバータを、高温雰囲気であるが電動機の内部にあっては比較的空いているスペースであって、また、インバータとの直結構造による電気接続の簡素化に繋がる、耐絶縁許容温度(MAX220°C)のステータコイルに近接して配設することができるようになり、スペース効率の向上を図り電動機の小形化を達成することができる。即ち、高耐熱や低熱損失の回転電機内蔵用インバータを内蔵し小形化したインバータ内蔵形回転電機が提供される。

【0044】ところで、ハイブリッドシステムカーや電気自動車に用いられる同期電動機30の各部の環境温度は、永久磁石の許容温度150°C、ステータコイルの耐絶縁許容温度220°C、他の内部雰囲気温度150°C~200°Cなどから定められるものである。この環境温度に依り、同期電動機30において、 $T_j = 220^\circ\text{C}$ 以上~ 300°C 以下のジャンクション温度特性を有している複数の半導体モジュールにより形成されたインバータ回路を有するインバータを内蔵した。

【0045】しかしながら、インバータ内蔵形回転電機が、例えば、車両用交流発電機であっても、該車両用交流発電機の比較的空いている高温雰囲気スペースに本発明による回転電機内蔵用インバータを内蔵することが可能となり、スペース効率の向上によって車両用交流発電機の小形化が図られることは明らかである。即ち、従来のSi-IGBTまたはSiC-MOSFETのジャンクション温度特性から定まる温度限界としての約155°Cを、SiC-SIT形半導体の特長を活かして、約155°Cより高い範囲の160°C~300°Cまでに温度限界を上げて、より高温で作動可能とした本発明によるインバータであれば、回転電機内の比較的空いたスペースに実装できて回転電機の小形化に有効である。尚、約155°Cよりも5°Cだけ高い場合であっても、半導体の自己発熱による温度上昇分だけ耐熱性が向上し有効であり、インバータならびにインバータを内蔵する回転電機を小型化できる効果がある。

【0046】

【発明の効果】本発明によって、耐熱性や低熱損失性が向上し冷却フィン寸法や回転電機の小形化に結び付く回転電機内蔵用インバータが提供される。また、耐熱性や低熱損失性に優れたインバータを比較的スペースの空いた高温雰囲気空間に配設することによって、回転電機の

小形化が図られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による一実施例の回転電機内蔵用インバータを示す正面図である。

【図2】図1の回転電機内蔵用インバータを示す側面図である。

【図3】本発明による一実施例のモジュールを示す断面図である。

【図4】図3のモジュールの回路構成を示す図である。

10 【図5】本発明による一実施例の回転電機内蔵用インバータに用いられる半導体モジュールのジャンクション温度特性を示す図である。

【図6】本発明による一実施例の半導体モジュールを構成するパワートランジスタの定格電圧 V_{ce} に対するオン抵抗特性を示す図である。

【図7】本発明による他の実施例の回転電機内蔵用インバータを示す正面図である。

【図8】図7の回転電機内蔵用インバータを示す側面図である。

20 【図9】図7の回転電機内蔵用インバータのモジュールの回路構成を示す図である。

【図10】本発明による一実施例の回転電機内蔵用インバータを用いたインバータ内蔵形回転電機の構成を示す半断面図である。

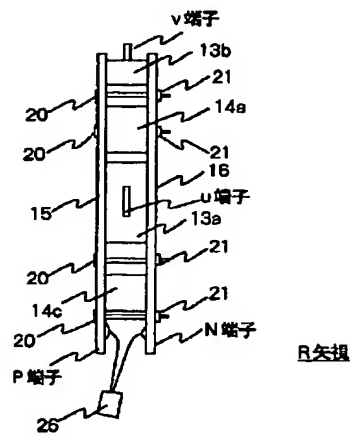
【図11】図1の回転電機内蔵用インバータを用いたインバータ内蔵形回転電機の駆動回路構成を示す図である。

【図12】図7の回転電機内蔵用インバータを用いたインバータ内蔵形回転電機の駆動回路構成を示す図である。

30

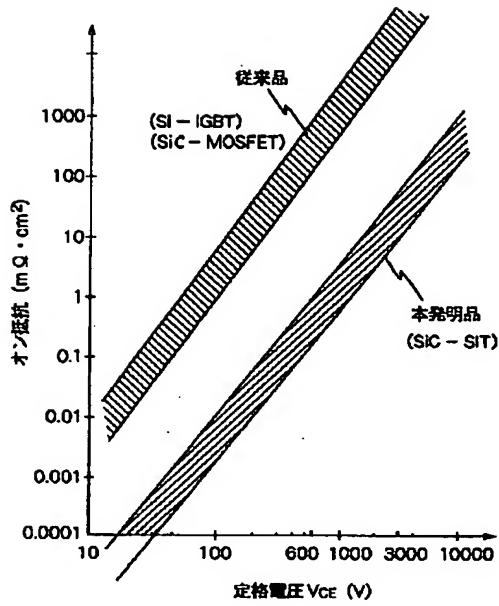
【符号の説明】

1a…インバータ、1b…一体型インバータ、2…ステータコア、3…ステータコイル、4…ロータコア、5…永久磁石、6…リアブラケット、7…アルミブレード、8…フロントブラケット、9…エンコーダ、10…モータボディ、11…ロータ、12…ステータ、13、13a、13b、13c、33、33a、33b、33c…SiC形モジュール(モジュール)、14、14a、14b、14c…コンデンサ、15…正極板、15s…正極側接点、16…負極板、16s…負極側接点、17、17a、17b、17c…インテリジェントドライバ(ドライバ)、18、18a、18b、18c、38…SiC-SIT(SIT)、19、19a、19b、19c、39…SiC-ダイオード(ダイオード)、20…ボルト、21…ナット、23…電流センサ、24a…信号線(G端子)、24b…信号線(Co端子)、25、35…コントローラ、26…電源線(P及びN端子)、30…同期電動機、31…成形体、32…ゲート、32a…ゲート電線、32b…ゲート電極、35…コネクタ、36…エミッタ、37…中間端子体、40…電源。



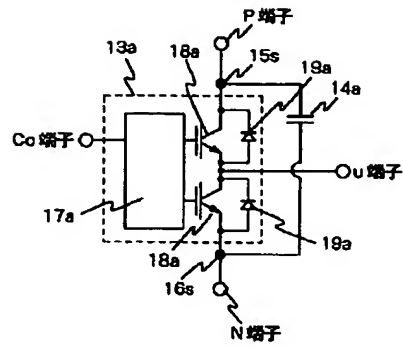
【図 6】

図 6



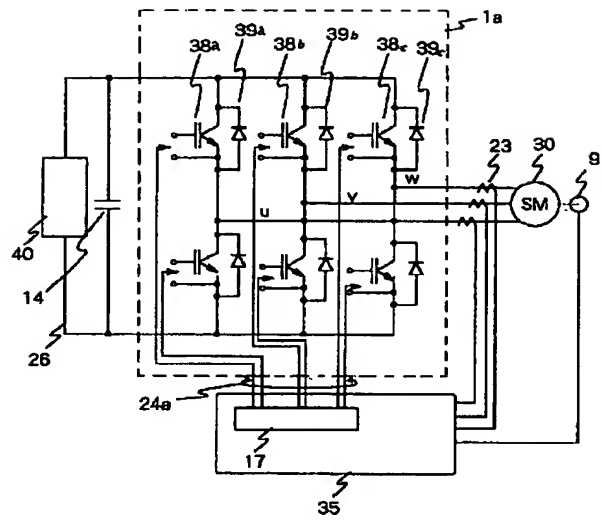
【図 9】

図 9



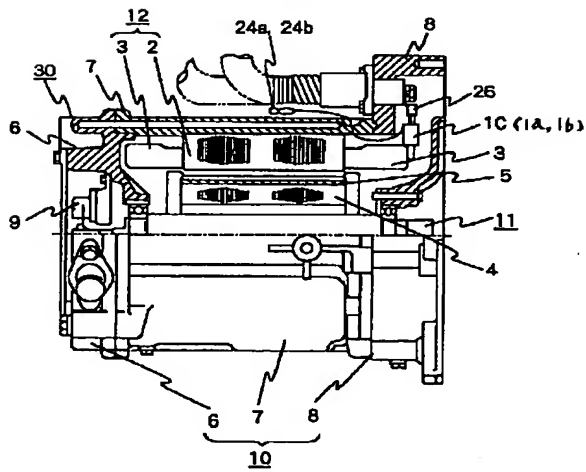
【図 11】

図 11



【図 10】

図 10



【図 12】

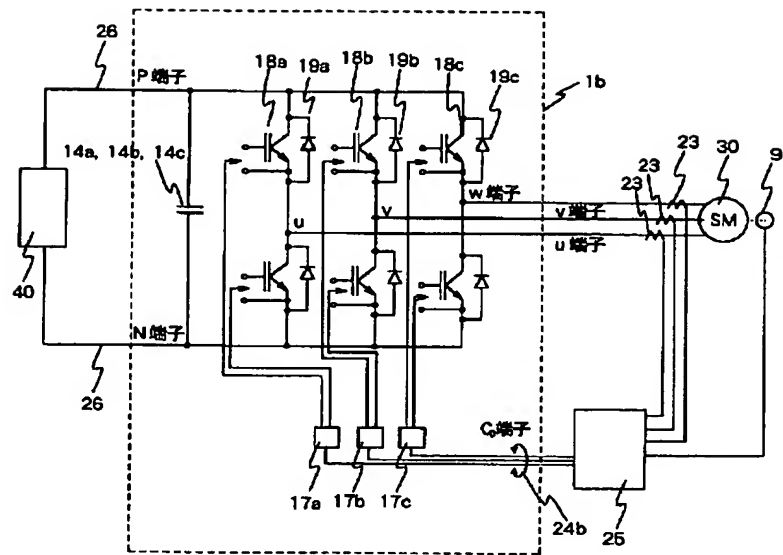


図 12

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☒ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☐ **FADED TEXT OR DRAWING**

☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.